文章编号:1000-7032(2014)12-1474-06

高功率半导体巴条激光器的热特性分析

李 江*,李 超,徐 昊,章 强,周旻超

(中国科学院苏州生物医学工程技术研究所半导体光电子技术研究室,江苏苏州 215163)

摘要:对采用5层叠焊的微通道无氧铜热沉冷却的巴条激光器进行了流体动力学(CFD)分析。建立了条宽 10 mm、腔长1.5 mm 巴条芯片的流固耦合共轭传热模型,得到了不同流量水冷下激光器的热阻和压力损失曲 线。分析了 300 mL/min 水流时,激光器的温度分布和冷却水的流动性能。实验条件下,测试了该微通道热沉 封装的 808 nm 巴条激光器的热阻和压力损失。数值计算和实验测试所得的结果一致,在 300 mL/min 水流 下,巴条热阻为0.38 ℃/W,在温度不高于 70 ℃时可满足连续模式下 90 W 的散热要求。

关 键 词: 半导体激光器; 计算流体动力学; 微通道热沉; 热阻 **中图分类号:** TN248.4 **文献标识码:** A **DOI**: 10.3788/fgxb20143512.1474

Thermal Analysis of High Power Semiconductor Laser Bar

LI Jiang*, LI Chao, XU Hao, ZHANG Qiang, ZHOU Min-chao

(Laboratory of Semiconductor Optoelectronic Technology, Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology, Chinese Academy of Sciences, Suzhou 215163, China) * Corresponding Author, E-mail; lij@ sibet. ac. cn

Abstract: Computational fluid dynamics (CFD) simulation and experimental analysis are presented for a semiconductor laser bar, which is cooled by a 5-layer oxygen-free copper micro-channel heat sink. A fluid-solid coupling conjugate heat transfer model is built for the micro-channel cooler and 10 mm-wide, 1.5 mm-cavities long bar. The curves of thermal resistance and pressure drop to flowing rate are plotted. The temperature of the laser bar and the characteristic of the cooling water are studied at 300 mL/min flowing rate. An experimental testing is performed for the thermal resistance and pressure drop of an 808 nm laser, which is packaged with the micro-channel cooler. The simulation results consistent with experiment. In the flowing rate of 300 mL/min, the thermal resistance is 0.38 C/W, which can dissipate a continuous 90 W heat below 70 C.

Key words: semiconductor laser; CFD; micro-channel cooler; thermal resistance

1引言

半导体激光器具有体积小、效率高、寿命长、 稳定可靠、使用成本低等优点,被广泛应用于国防 (激光雷达、激光引信、激光制导和跟踪等)和国 民经济(光通信、激光治疗、激光加工等)各领域, 已在激光行业中占据了不可替代的重要地位^[1]。 近年来,随着半导体激光器功率的不断增大,其工 作过程中产生的大量废热已严重制约半导体激光 器性能的进一步提高。半导体激光器的输出特性 与其有源区的工作温度(结温)密切相关,随着结 温的升高,会产生激光器效率下降、阈值电流增

收稿日期: 2014-08-22; 修订日期: 2014-09-14

大、波长红移、内部缺陷增加等一系列问题,严重 影响激光器的寿命^[2]。目前,国内外广泛使用的 无氧铜微通道热沉具有热阻小、制备工艺简单、成 本低、适用于模块化阵列等优点,已成为半导体巴 条激光器(将巴条芯片和无氧铜热沉封装在一 起)高效散热技术的标准配置。国内外一些文献 对微通道热沉冷却的巴条激光器热特性进行了分 析^[36]。这些报道主要集中在对微通道的特征尺 寸和热沉的结构进行优化上,对巴条激光器的温 度场特性尚缺乏深入的分析。本文采用 CFD 数 值模拟和物理实验的方法分析了 808 nm 微通道 热沉冷却的巴条激光器热特性,对进一步改进微 通道巴条激光器的热性能具有重要的参考意义。

2 数值模拟和结果

2.1 热沉的数值模型

微通道内冷却水的流动视作三维稳态不可压 缩粘性湍流,冷却水和热沉之间的对流换热可表 示为通用的控制方程形式:

$$\frac{\partial(\rho\Phi)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho U\Phi) = \operatorname{div}(\Gamma_{\phi}\operatorname{grad}\Phi) + S_{\phi},$$
(1)

式中: Φ 为通用变量; ρ 和 U 分别表示材料密度和 速度矢量; Γ_{ϕ} 和 S_{ϕ} 分别为广义扩散系数及广义 源项,二者取不同表达式时,可将式(1)分别推导 为连续性方程、动量守恒方程、能量守恒方程和湍 流模型输运方程^[7]。

图 1 所示为巴条激光器的结构模型。微通道 热沉采用 5 层无氧铜薄片叠焊而成。巴条芯片条 宽为 10 mm,腔长为 1.5 mm。热沉内部 10 个微 通道的特征尺寸为宽 0.35 mm、高 0.25 mm。为



图 1 巴条激光器的结构 Fig. 1 Structure of the laser bar

了减小阻力,回水层微通道向两边伸出。两端微 通道长度短,中间微通道长度长,这样对巴条中间 散热更充分,减小条宽方向温度差异。去离子冷 却水温度设定为 20 ℃,流量设定为 100 ~ 700 mL/min,出口设定为参考压力。巴条芯片 P 面朝 下封焊在微通道热沉上。巴条激光器工作时,冷 却水由热沉的底层通过入水层进入微通道,通过 隔离层前端巴条正下方的通道,进入回水层,再到 出口。微通道内冷却水和无氧铜之间有很大的换 热效率,可以将巴条激光器的大量废热带走。

本文研究的巴条芯片填充因子大于 70%,发 光单元大于 60个,连续模式下功率为 90 W,光电 转换效率约为 50%。巴条芯片整体作为发热源, 设定其发热功率为 90 W。只考虑冷却水对巴条 激光器的对流换热,忽略空气对巴条激光器的对 流换热。湍流模型采用 *k-c* 模型。巴条芯片材料 GaAs 导热系数 44 W/(m·K),无氧铜导热系数 为 380 W/(m·K)。

模拟计算主要分3步,分别建立固体和液体 模型,利用第三方软件对模型进行网格划分,设定 边界条件用软件进行模拟计算。

利用网格工具进行网格划分时,既要控制网格数量,避免计算规模过大,又要保证计算精度。如此,本文在划分网格的时候,将微通道处网格尺度调为 0.05 mm,,其余地方网格尺度为 0.15 mm。网格模型中所有网格为四面体,总体网格数为 100 万。图 2 是划分后的网格模型,因为结构对称,所以只取一半做网格划分。



Fig. 2 Mesh model

模拟计算的边界条件如下:高功率半导体激 光器芯片与热沉焊接的热界面尺寸是 10 mm × 1.5 mm,设计参数为产热量 90 W。本文中将热 源作为平均热源来处理,因此芯片与热沉表面的 平均热流密度是 6×10⁶ W/m²。入口流量分别设 定为 100,200,300,400,500,600,700 mL/min,水 温 20℃。出口条件为 1 个标准大气压 1.01×10⁵ Pa。

2.2 热阻和压力损失分析

微通道热沉冷却的半导体巴条激光器热阻定 义为^[8]:

$$R_{\rm th}(Q_{\rm f}) = \frac{T - T_0}{Q},$$
 (2)

式中: $R_{th}(Q_f)$ 表示冷却水流量为 Q_f 时的热阻;T为巴条有源区的最高温度; T_0 为冷却水入口处温度,巴条工作时由制冷机供应 20 ℃的去离子水;Q为有源区的发热功率,设定为 90 W。

实际液体是有黏性的,为了克服黏性摩擦阻力,液体流动时要损耗一部分能量。由于管道中流量不变,因此这种能量损耗表现为压力损失。 压力损失产生的内因是液体本身的黏性,外因是 管道结构。液体在管道中流动时产生的压力损失 分为两种:一种是液体在等径直管中流动时因黏 性摩擦而产生的压力损失,称为沿程压力损失;另 一种是由于管道的截面突然变化、液流方向改变 或其他形式的液流阻力(如控制阀阀口)而引起 的压力损失,称为局部压力损失^[9]。

微通道热沉通以不同流量冷却水时,热阻、流 量和压力损失三者有密切关系。表1给出了数值 模拟的不同流量下巴条热阻和压力损失的结果, 图3所示为相应的拟合曲线。由图中可以看出, 增加冷却水的流量能够降低巴条激光器的热阻, 但相应的压力损失也增高,且随着流量的增加,热 阻下降效率降低,压力损失则显著提高。实际过

表1 热阻和压力损失的仿真结果

Table 1 Simulation results of thermal resistance and pressure drop

Flowing rate/ $(mL \cdot min^{-1})$	Thermal resistance/ $(\mathcal{C} \cdot W^{-1})$	Pressure drop/ (10 ⁵ Pa)
100	0.606	0.28
200	0.527	0.53
300	0.474	0.86
400	0.435	1.30
500	0.401	1.80
600	0.383	2.39
700	0.364	3.11



图 3 热阻和压力损失数值仿真和实验测试曲线

Fig. 3 Simulation and experiment results of thermal resistance and pressure drop

程中,受限于热沉制备工艺和使用工艺条件,巴条 激光器通常通以 200~300 mL/min 冷却水;封装 为叠阵时,则平均每只巴条激光器通以 150~200 mL/min 冷却水。

2.3 巴条激光器温度分布和冷却水流动特性

不同流量下巴条的温度分布和微通道内水的 流动具有相似的场分布特性,本文选取巴条激光 器测试流量 300 mL/min 进行研究。图 4 所示为



图 4 冷却水流量为 300 mL/min 时的激光器的温度分布

Fig. 4 Temperature distribution of the laser bar at flowing rate of 300 mL/min



图 5 冷却水流量为 300 mL/min 时的冷却水流速

Fig. 5 Velocity of the cooling water in micro-channel heat sink at flowing rate of 300 mL/min

该流量下巴条激光器的温度分布。整个激光器温 度最高处集中在巴条芯片有源区发光腔面中心, 其值为67.4 ℃。巴条芯片沿条宽方向呈现两端 温度低、中间温度高的分布;沿垂直条宽远离巴条 芯片方向温度则迅速下降,出水口处温度接近供 水温度。

图 5 所示为冷却水流量为 300 mL/min 时在 微通道内的流速。可以看出,冷却水经过微通道 时因阻力变大,压力损失迅速增大,流速激增。在 巴条条宽方向,两端微通道内的流速比中间微通 道流速要大。

2.4 巴条激光器条宽方向和垂直条宽方向温度 曲线

图 6 和图 7 给出了不同流量下条宽方向和垂 直条宽方向巴条激光器的温度变化曲线。如前所 述,条宽方向的发光腔面表现为中间温度高、两边 温度低;在与条宽垂直的方向,巴条芯片 1.5 mm 腔长范围内的温度下降为 3 ~5 ℃。沿条宽方向 的温度不均匀性容易导致巴条激光器光谱展宽, 热应力会使"Smile"效应加剧^[10]。



图 6 发光腔面条宽方向的温度分布





图 7 垂直于条宽方向的温度分布



图 8 是巴条激光器通过光栅分光原理将巴条 激光器中的每一个发光单元的一级光谱成像在 CCD 上,横轴表示每个发光点的物理分布,纵轴 表示发光点的相对波长(nm)。可以看出由于散 热不好,中间发光点的波长比两边大。



图 9 给出了不同流量下条宽方向巴条温度差 异的曲线。从图中可以看出,在不同的冷却水流 量下,巴条激光器条宽方向的发光腔面温度差异 在 6.83 ~ 7.64 ℃之间,温差数值随流量呈线性降 低,该变化趋势约为 0.135 ℃/(100 mL/min)。



图 9 不同冷却水流量下的巴条条宽方向上的温度差



3 实验测试和结果

3.1 测量方法

采用实验测试的方法对直接影响巴条激光器使用性的热阻和压力损失进行分析。根据式(2),对于变量*T*,可利用半导体激光器波长红移和温度升高的对应线性关系来测得,其关系为:

$$a = \frac{\lambda_{i+1} - \lambda_i}{T_{i+1} - T_i},\tag{3}$$

式中: T_i 和 λ_i 为对应的巴条芯片有源区最高温度

和波长;α为半导体激光器温漂系数,对于808 nm GaAs半导体激光器,其取值为0.28 nm/℃。

Q 为激光器的发热功率,可通过下面的公式 计算:

$$Q = UI - P, \tag{4}$$

式中:U、I分别为巴条的电压和电流,P为巴条激 光器的发光功率。

根据式(2)、(3)、(4)可得

$$R_{\rm th}(Q_{\rm f}) = \frac{\lambda_{i+1} - \lambda_{i}}{\alpha [(U_{i+1}I_{i+1} - P_{i+1}) - (U_{i}I_{i} - P_{i})]},$$
(5)

热阻即为引入 α 的波长和巴条激光器发热功率 关系曲线的斜率。

图 10 所示为实验测试台的示意图。激光驱 动电源受计算机控制,提供巴条激光器工作时所 需的电流,计算机记录电流和电压信号。制冷机 提供去离子水,水路中安装的压力传感器和流量 传感器分别采集压力和流量信号。功率计和光谱 仪采集激光的光功率和波长信号。

利用该激光器测试台测得的巴条激光器光功 率-电流-电压(*L-I-V*)曲线和光谱(测试条件为电流 90 A,水流 250 mL/min)分别如图 11 和图 12 所示。



图 10 实验测试台示意图





图 11 实验测得的巴条激光器的光功率-电流-电压曲线





图 12 实验测得的巴条激光器的光谱



测试台还具有一级光谱图像的采集模块。通 过采集一级光谱图像,可以分析巴条激光器中间 发光点和两边发光点之间的波长漂移,如图 8 所示。

3.2 测试结果

表2给出了实验测得的100~700 mL/min冷却水流量下的热阻和压力损失。多纵模可能会因为驱动电流或冷却条件变化发生光谱畸变,此时 波长的变化就不仅是由温度引起了。在实验测试中,驱动电流和水流量变化并未引起光谱畸变,因 此可以用波长的漂移来推算温度的变化。为了便于比较,我们将二者拟合曲线放置在图2中。对 比数值仿真结果和实验测试结果,发现二者具有 相同的变化趋势。实验测试的热阻比数值计算结 果小0.10℃/W。造成该误差的主要原因是:微 通道热沉内部微通道特征尺寸为百微米级,相对 常规尺寸而言,其流动雷诺数更小,湍流效应更 大,流动阻力更大,换热更充分。目前对微尺度换 热的研究还不成熟,本文采用常规计算流体动力

表 2 热阻和压力损失的实验结果

 Table 2
 Experimental results of thermal resistance and pressure drop

Flowing rate/ (mL • min ⁻¹)	Thermal resistance/ $(\mathcal{C} \cdot W^{-1})$	Pressure drop/ (10 ⁵ Pa)
100	0.506	0.31
200	0.440	0.61
300	0.382	1.23
400	0.355	1.84
500	0.330	2.68
600	0.311	3.44
700	0.285	4.51

学的理论进行研究,换热效率较真实物理模型更 小^[11],因此热阻计算结果比实验测试结果偏大。

此外,我们还利用测试台测试了巴条激光器 的冷波长。在占空比为 1‰的脉冲电流条件下 (此时巴条发热可以忽略)测量巴条激光器的波 长,再在连续模式 90 W 散热条件下测量巴条激 光器的波长,两者的波长差小于 11 nm。按照波 长温度系数 0.28 nm/℃来推算,在 90 W 散热条件 下,巴条芯片结温比环境温度上升不大于 40 ℃。

4 结 论

利用数值计算和实验测试的方法分析了微 通道冷却的巴条激光器的热特性,并对结果误 差进行了定性分析。随着冷却水流量的增加, 巴条激光器热阻变小,压力损失变大。流量增 大后,热阻下降趋势降低,压力损失则显著提 高。在巴条激光器发光腔面有源区的条宽方向 上,温度分布表现为中间高、两边低,温度差值 为6.83~7.64 ℃,与模拟计算相差1~2℃,该 温度差值随流量表现为1.35 ℃/L的线性降低 变化。在300 mL/min 的冷却水流量下,巴条激 光器热阻的数值计算结果和实验测试结果分别 为0.474 ℃/W 和 0.382 ℃/W。可以推断,巴 条在连续模式下工作在90 W 散热条件时,温度 不会超过70 ℃,这与根据冷波长测量的结果进 行的推算是相吻合的。

参考文献:

- [1] Wang D, Li X Q. Latest developmentst and application status of diode lasers [J]. Opt. Precision Eng. (光学 精密工程), 2001, 9(3):279-283 (in Chinese).
- [2] Tian Z H, Sun C L, Cao J S, et al. Junction temperature measurement of high power diode lasers [J]. Opt. Precision Eng. (光学 精密工程), 2011, 19(6):1244-1249 (in Chinese).
- [3] Kreutz E W, Pirch N, Ebert T, et al. Simulation of micro-channel heat sinks for optoelectronic microsystems [J]. Microelectron. J., 2000, 31(9):787-790.
- [4] Yu E C, Prekwas A J. Thermomechanical design of a microchannel cooled semiconductor laser diode array package [J]. SPIE, 1999, 3625:535-542.
- [5] Yao S, Ding P, Liu J, et al. Microchannel heat sink of high beam quality semiconductor laser array [J]. Chin. J. Laser (中国激光), 2009, 36(9):2286-2289 (in Chinese).
- [6] Hu L M, Li Z J, Qin L, et al. Thermal analysis of high-power, high-duty-cycle laser diode array [J]. Acta Optica Sinica (光学学报), 2010, 30(4):1055-1060 (in Chinese).
- [7] Tao W Q. Numerical Heat Transfer [M]. Xi'an: Xi'an Jiaotong University Press, 2001:1-14 (in Chinese).
- [8] Joyce W B, Dixon R W. Thermal resistance of heterostructure lasers [J]. J. Appl. Phys., 1975, 46(2):855-862.
- [9] Wang S C, Rong Y M. Hydraulic Transmission [M]. Beijing: Chinese Forestry Press, 2006, 8:37-37 (in Chinese).
- [10] Xu H W, Ren Y X, An Z F, et al. Packaging of 808 nm 1 500 W continuous wave operation perpendicularity laser diode stack [J]. Chin. J. Laser (中国激光), 2010, 37(11):2286-2289 (in Chinese).
- [11] Guo Z Y. Frontier of heat transfer-microscale heat transfer [J]. Adv. Mechan. (力学进展), 2000, 30(1):1-6 (in Chinese).



李江(1963 -),男,江苏苏州人,研 究员,1995 年于南开大学获得博士 学位,主要从事半导体激光器方面 的研究。 E-mail; lij@ sibet. ac. cn